

1983年全国砷化镓和有关化合物 学术交流会在上海召开

由中国金属学会半导体材料专业委员会和上海市金属学会负责筹备的1983年全国砷化镓及有关化合物学术交流会于1983年11月21日至25日在上海召开。参加会议的代表除来自国内53个单位的127名外,还邀请了4名国外学者。

会议收到论文报告135篇,会上宣读119篇,其中包括英文宣读的大会报告15篇。这些论文反映了我国在Ⅲ-V族化合物方面科研工作的进展。

从这次会议的论文看,在材料方面已取得许多进展,新的生长工艺,如MBE和MOCVD已开展工作,和材料品种已显著增加。在材料生长机理、杂质和缺陷的行为,表面和界面物理,发光机理以及特性测试等方面都做了比较详细的探讨,提出了值得注意的见解。对光电子学和砷化镓集成电路等新领域也都开始了探索。

参加会议的4名国外学者分别就砷化镓单晶生长,外延生长,半导体激光器和集成电路等专题宣读了论文和进行了专题座谈。这些活动对我们了解国际动向有所帮助。

会议建议下届会议在85年召开,地点由中国金属学会半导体学术委员会与有关方面商讨后决定。

(彭瑞伍)

Symposium on Gallium Arsenide and Related Compounds

Shanghai, China, Nov. 21—25, 1983

第三届全国“三束”及超精细工艺技术学术年会征文启事

为总结、交流“二届”会议以来,在“三束”(电子束、离子束和光子束)及超精细工艺技术研究与应用方面的进展,经中国电子学会批准,半导体与集成技术学会委托中国科学院半导体研究所和清华大学微电子学研究所共同筹备第三届全国“三束”及超精细工艺技术学术年会,会议定于一九八四年下半年在北京召开,会上将集中举行学术报告,开展学术讨论,约请特邀报告,现将本届年会征文的有关事宜通知如下。

一、征文内容

1.光、电子束、软X射线和离子束曝光方法、工艺技术及其在器件和集成电路中的应用。2.光刻胶制备、特性和应用以及多层胶的图形转换技术。3.等离子、反应离子和离子束刻蚀工艺技术。4.硅和化合物半导体材料的离子注入技术及其应用。5.激光、电子束和离子束退火方法及物理过程分析。6. SOI 技术及其应用。7.束技术用于超薄层的生长工艺及其物理过程分析(如分子束外延、离子束外延等)。8.超精细加工中引入的辐射损伤及其分析。9.图形和掺杂层的物理、化学和电子学检测分析。10.应用超精细工艺方法探索高分辨率的器件工艺结构。

二、征文要求

1.征文为详细摘要,应突出作者的研究工作和所取得的进展,要求论点明确、数据可靠、文责自负。
2.稿件一律由所在单位主管部门推荐并加盖公章寄送我组。凡已在全国性学术刊物或会议发表交流过的,不再录用。
3.征文截止日期为一九八四年六月三十日。征文作者务必在截止日(以当地邮戳为止)前一式三份其中一定要有打印原稿(以便制版),寄送北京中国科学院半导体研究所刘宗德收。

4.凡被录用论文,拟在会前采用 1:1 胶版印编成论文集,因此,稿件即是制版的原件,故必须符合下列统一的规格要求:

- (1)文字一律用4号中文打字机直接打印在60克八开古版纸上,横30字,纵25行,上下间距5分,中缝30mm。文头按题目、作者、单位各占一行居中排列,隔行打正文。全文(包括图表、照片)限在一页之内;不编页码;
- (2)图表要用绘图墨水描制,文字及图表均要字迹清晰。黑白反差好,照片要紧贴粘平;
- (3)稿件切忌折叠,邮寄时只能沿中心间隔的中线折叠。

三、征文处理

征文截止后即组织有关专业人员选稿,被录用者将及时通知作者所在单位,未被录用者恕不退稿。具体开会日期另行通知。

半导体与集成技术学会三束及超精细加工学组
一九八四年二月二十一日

* 我学组前两届年会是与生产技术学会的“三束”学组联合举行的,分开举行是首次,但仍序称第三届。

“第二届全国固体光学性质学术会议”征文通知

经中国物理学会批准,“第二届全国固体光学性质学术会议”将于1984年第四季度,在杭州或其他地方召开。现将征文有关事项通知如下:

一、征稿内容:

- 1.固体的光吸收和光反射效应;
- 2.固体光散射;
- 3.固体的发射光谱和荧光光谱;
- 4.固体光学性质的理论研究;
- 5.研究固体物理性质的光学技术及方法。

二、征文要求:

- 1.论文要反映国内先进水平。
- 2.凡已在国内外学术会议上交流或已在国内外公开发行人物上发表过的论文,不予接受。
- 3.应征论文请报送1500字以内的详细摘要,突出作者自己的工作内容和主要结果,以供评审用。
- 4.会议拟选部分论文作为大会报告,大会报告论文除了水平较高的研究报告外,也有少数属于综述性或介绍重要发展动向的。凡准备提供作大会报告的论文,请先由作者单位推荐,加注标明,加盖公章,以供评选。
- 5.会议拟出版“论文摘要集”。论文摘要请按印刷出版要求,用方格稿纸和钢笔书写,字迹端正清晰,可以有表格,但不要插图和照片。格式为:题目、作者、单位(用括号写在作者姓名下面)各起一行,以下写摘要全文。

三、征文办法和截止日期:

- 1.征文请于1984年6月30日以前(以当地发信邮戳日期为准),寄交北京中国科学院半导体研究所科技处收。请注明“全国固体光学性质学术会议征文”,并在文稿上用铅笔注明作者的联系地址和姓名。逾期不收。

- 2.应征论文经会议论文审稿小组评审后,录用情况将尽快通知作者本人或单位。

- 四、学术会议具体日期、地点及参加会议代表名额分配等有关会议事项,将于论文审定后,另行通知。

“第二届全国固体光学性质学术会议”秘书组